

D10SBS4

40V 10A

特長

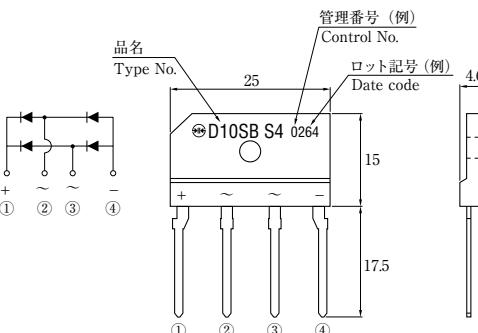
- ・薄型 SIP パッケージ
- ・SBD ブリッジ
- ・低 V_F

Feature

- ・Thin-SIP
- ・SBD Bridge
- ・Low V_F

■外観図 OUTLINE

Package : 3S

Unit : mm
Weight : 3.9g (typ.)

外形図については新電元 Web サイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection."

■定格表 RATINGS

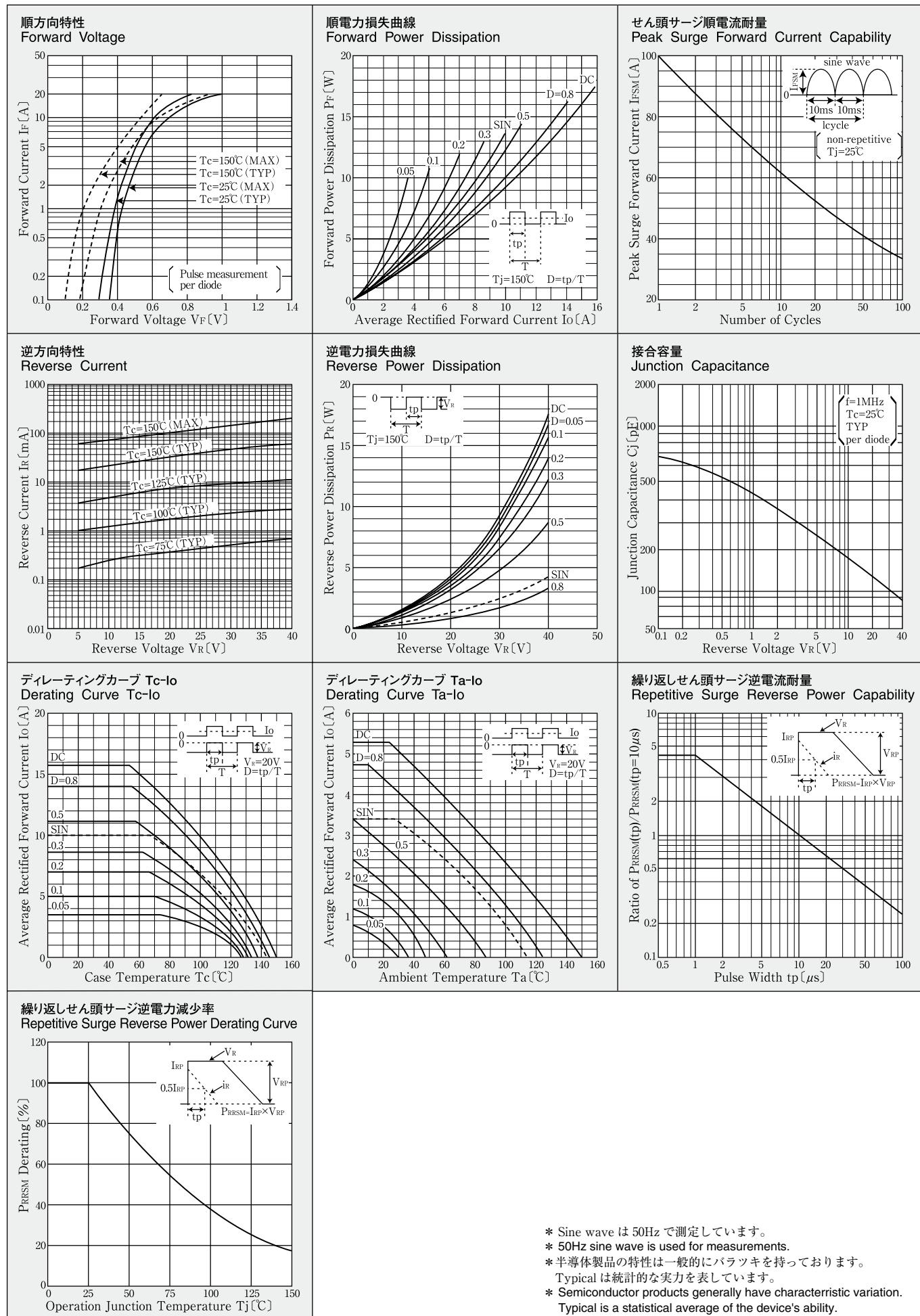
●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $T_c=25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	D10SBS4	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg			-55~150	°C
接合部温度 Operation Junction Temperature	T _j			150	°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V _{RM}			40	V
繰り返しせん頭サージ逆電圧 Repetitive Peak Surge Voltage	V _{RRSM}	パルス幅0.5ms, duty 1/40 Pulse width 0.5ms, duty 1/40		45	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I _O	50Hz 正弦波, 抵抗負荷 50Hz sine wave, Resistance load	フイン付き With heatsink T _c = 67°C フインなし Without heatsink T _a = 25°C	10 3.4	A
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz 正弦波, 非繰り返し 1 サイクルせん頭値, T _j = 25°C 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, T _j = 25°C		100	A
繰り返しせん頭サージ逆電力 Repetitive Peak Surge Reverse Power	P _{RRSM}	パルス幅10μs, 1 素子当たり, T _j = 25°C Pulse width 10μs, per diode, T _j = 25°C		330	W
絶縁耐圧 Dielectric Strength	V _{dis}	一括端子・ケース間, AC 1 分間印加 Terminals to Case, AC 1 minute		2	kV
締め付けトルク Mounting Torque	T _{OR}	(推奨値: 0.5 N·m) (Recommended torque : 0.5 N·m)		0.8	N·m

●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $T_c=25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

順電圧 Forward Voltage	V _F	I _F = 5A, パルス測定, 1 素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 0.55	V
逆電流 Reverse Current	I _R	V _R = V _{RM} , パルス測定, 1 素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 3.5	mA
接合容量 Junction Capacitance	C _j	f = 1MHz, V _R = 10V, 1 素子当たりの規格値 per diode	TYP 180	pF
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{jc}	接合部・ケース間, フィン付き Junction to Case, With heatsink	MAX 5.5	°C/W
	θ _{jl}	接合部・リード間, フィンなし Junction to Lead, Without heatsink	MAX 6.0	
	θ _{ja}	接合部・周囲間, フィンなし Junction to Ambient, Without heatsink	MAX 30	

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



* 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っています。
Typical は統計的な実力を表しています。
* Semiconductor products generally have characteristic variation.
Typical is a statistical average of the device's ability.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помошь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помошь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.